
	<h2 style="color: #E67E22;">SI3812DV-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI3812DV-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 2A 6-TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3812DV-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2890 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI3812DV-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 2A 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	2890 pcs Stock
Serie	LITTLE FOOT®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	830mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 2.4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	600mV @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI3812DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3812DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3812DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3812DV-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3812DV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 2A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3831DV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IC PWR SW BI-DIR PCHAN 6TSOP</p>	 <p><b>SI3812DV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 2A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3805DV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.3A 6-TSOP</p>
 <p><b>SI3812DV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 2A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3831DV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix IC PWR SW BI-DIR PCHAN 6TSOP</p>	 <p><b>SI3805DV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.3A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3831DV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix IC PWR SW BI-DIR PCHAN 6TSOP</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI3585DV	 SI3585DV-T1	 SI3585DV-T1-E3	 SI3585DV-T1-E3	 SI3585DV-T1-GE3
 SI3585DV-T1-GE3	 SI3586DS-TI-E3	 SI3586DV	 SI3586DV-T1-E3	 SI3586DV-T1-E3
 SI3586DV-T1-GE3	 SI3586DV-T1-GE3	 SI3588DV	 SI3588DV-T1-E3	 SI3588DV-T1-E3
 SI3588DV-T1-GE3	 SI3588DV-T1-GE3	 SI3590DV-T1-GE3	 SI3590DV-T1-GE3	 SI3801DV-T1
 SI3803DV-T1	 SI3805DV-T1	 SI3805DV-T1-E3	 SI3805DV-T1-E3	 SI3812DV-T1-GE3
 SI3850ADV-T1-E3	 SI3850ADV-T1-E3	 SI3850ADV-T1-GE3	 SI3850ADV-T1-GE3	 SI3850DV-T1
 SI3850DV-T1-E3	 SI3850DV-T1-GE3	 SI3851DV	 SI3851DV-T1	 SI3851DV-T1-E3
 SI3851DV-T1-E3	 SI3851DV-T1-GE3	 SI3853DV-T1-E3	 SI3853DV-T1-E3	 SI3861BDV-T1-GE3
 SI3861BDV-T1-GE3	 SI3861DV-NL	 SI3861DV-T1-E3	 SI3863BDV-T1-GE3	 SI3863DV-T1-E3
 SI3863DV-T1-GE3	 SI3865BDV-T1-E3	 SI3865BDV-T1-E3	 SI3865CDV-T1-GE3	 SI3865CDV-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited